05,11

Особенности формирования магнитокалорических явлений в системах Mn_{1-t}Ti_tAs и Mn_{1-x}Cr_xNiGe

© В.И. Вальков¹, И.Ф. Грибанов¹, Б.М. Тодрис¹, А.В. Головчан^{1,2}, В.И. Митюк³

¹ Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, ДНР ² Донецкий национальный университет, Донецк, ДНР ³ НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, Минск, Беларусь E-mail: valkov09@gmail.com

> В рамках модели взаимодействующих параметров магнитного и структурного порядков проведен анализ магнитокалорических свойств систем, обладающих разнесенными (совмещенными) по температуре магнитными (парамагнетизм (PM)-ферромагнетизм (FM)) и структурными (гексагональная-орторомбическая решетки) переходами. Показано, что в зависимости от характера сочетания низкосимметричной орторомбической (*P_{nma}*) и высокосимметричной гексагональной (*P*6_{3/mmc}) фаз с ферромагнитным порядком можно ожидать усиления или ослабления магнитокалорических характеристик системы при совмещении структурного (*P*6₃/*mmc*-*P_{nma}) и магнитного (PM-FM*) переходов.

DOI: 10.21883/FTT.2018.06.45985.13M

1. Введение

Изменение температуры (ΔT) системы при ее адиабатическом намагничивании (размагничивании) называют магнитокалорическим эффектом (МКЭ) [1]. Основу МКЭ составляет сохранение полной энтропии системы S(T, P, B), как функции температуры — T, давления — P и магнитной индукции — B при адиабатическом изменении магнитного поля. В этом случае для изобарического процесса выражение для изменения температуры — ΔT пропорционально $\Delta S_m(T, P, B)$ — изменению магнитоактивной части ($S_m(T, P, B)$) энтропии

$$\Delta T \approx \frac{-\Delta S_m(T, P, \Delta B)}{C_{P,B}/T} = \frac{-[S_m(T, P, 0) + S_m(T, P, B_0)]}{C_{P,B}/T}$$

Для ферромагнетиков (FM), у которых FM-порядок возникает в результате магнитоструктурного перехода, максимальное значение ΔT достигается вблизи температуры перехода за счет включения в $\Delta S_m(T, P, B)$ дополнительных вкладов [2]. Теоретический анализ влияния совмещения магнитного и структурного переходов на магнитные и магнитокалорические свойства проведем на примере систем Mn_{1-t}Ti_tAs и Mn_{1-x}Cr_xNiGe.

2. Экспериментальные данные

Пниктиды на основе MnAs [3] и полугейслеровы германиды на основе MnNiGe, в частности $Mn_{1-t}Ti_tAs$, $Mn_{1-x}Cr_xNiGe$ [4,5,6], $MnCo_xNi_{1-x}Ge$ [7,8] и др. относятся к классу материалов, перспективных для использования в качестве рабочих тел магнитных рефрижераторов, действие которых основано на магнитокалорическом эффекте, сопровождающем индуцированные магнитным полем фазовые переходы беспорядок-порядок

или порядок—порядок. На фоне всех различий химического состава и свойств пниктидов и германидов полезно сфокусировать внимание на общих чертах рассматриваемых систем:

1. Ниже температуры кристаллизации высокотемпературное парамагнитное (PM) состояние реализуется в гексагональной кристаллической решетке типа NiAs $(B8_1)$ (пниктиды), Ni₂In (германиды) с группой симметрии $P6_3/mmc$, элементарная ячейка которой обозначена на рис. 1 штрих-пунктирной линией.

2. Последующее понижение температуры приводит к парамагнитным структурным переходам типа смещения PM(hex) - PM(orth). Эти переходы, приводящие к изменению симметрии решетки от гексагональной к орторомбической (группа симметрии P_{nma}) реализуются как смещения ионов из положений равновесия в гексагональной структуре [9,10] и сопровождаются удвоением элементарной ячейки в базисной плоскости. Это позволяет выбрать неприводимый вектор смещений ионов Мn в качестве единого параметра структурного порядка для обеих систем [11]. Элементарная ячейка орторомбической структуры (типа MnP для пниктидов и TiNiSi для германидов) выделена на рис. 1 сплошными линиями.

3. Переход к парамагнитной структуре типа MnP(B31) в пниктидах является переходом второго рода и сопровождается плавным непрерывным возрастанием смещений u_1 . При увеличении давления температура этого перехода (T_t) возрастает $(\partial T_1/\partial P \approx \approx +12 \text{ K/kbar})$ [9], рис. 2, *a*, *b*.

4. Возникновение парамагнитной орторомбической структуры типа TiNiSi в германидах реализуется как переход первого рода и сопровождается скачкообразным возникновением смещений *u_i* и гигантской объем-



Рис. 1. Элементарные кристаллические ячейки MnAs (a), MnNiGe (b) в ромбической установке. Параметры ячейки (толстые линии) определены так, что $c \parallel x$, $b_{orth} \parallel a_{hex} \parallel y$, $a_{orh} \parallel c_{hex} \parallel z$; смещения атомов марганца при переходе $(P6_3/mmc) - (P_{nma})$ описываются векторами **u**. Штрих-пунктирные линии в базисной плоскости выделяют элементарные NiAs (a), Ni₂In (b) гексагональные ячейки.



Рис. 2. Магнитные фазовые P-T диаграммы систем $Mn_{1-t}Ti_tAs(a, b)$ [9,12] и $Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe(c)$. $\Box(\blacksquare)$ — температуры возникновения (исчезновения) гексагональной $FM(B8_1)$ фазы (a, b): ромбической FM(TiNiSi) фазы (c); \blacktriangle — температуры T_t парамагнитных структурных переходов 2-го рода $PM(B8_1)-PM(B31)(a, b)$, $\blacktriangle(\bigtriangleup)$ — температуры $T_{t1}(T_{t2})$ возникновения (исчезновения) ромбической фазы PM(TiNiSi) при структурных переходах 1-го рода $PM(Ni_2In)-PM(TiNiSi), (c)$; \diamondsuit — температуры возникновения $FM(B8_1)$ фазы, найденные методом экстраполяции критических полей индуцирования переходов $PM(B31)-FM(B8_1)$, $AF(B31) \rightarrow FM(B8_1)$ к нулевому полю; \bigtriangleup — температуры Нееля T_N : \bullet — парамагнитная температура Кюри θ .

ной стрикцией ~ 2.6% [13]. Температуры лабильности T_{t1} , T_{t2} фазовых переходов понижаются с ростом давления $\partial T_{t1}/\partial P > \partial T_{t2}/\partial P \approx -6$ K/kbar, рис. 2, *c* [14].

5. Однако коренное различие между исследуемыми германидами и пниктидами проявляется в характере сопряжения ферромагнитного порядка с орторомбической симметрией. В пниктидах при атмосферном давлении орторомбическая структура не совместима с высокоспиновой ($\mu_h \approx 3.4\mu_B$) FM фазой, рис. 3, *а*. В германидах, напротив, возникновение орторомбической симметрии в результате парамагнитного структурного перехода первого рода $PM(P6_3/mmc) \leftrightarrow PM(P_{nma})$ способствует стабилизации высокоспинового состояния $FM(P_{nma})$, рис. 3, b. Так, парамагнитная температура Кюри орторомбической фазы θ_{orth} , которая практически совпадает с температурой возникновения FM порядка, превосходит парамагнитную температуру Кюри θ_{hex} для гексагональной фазы [11]. В пниктидах, напротив, поведение обрат-



Рис. 3. Температурные зависимости намагниченности M и обратной магнитной восприимчивости χ^{-1} в MnAs (a) и в отожженном Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe (b) [11]. Закрытые символы соответствуют нагреву, а открытые — охлаждению образцов; температурные зависимости (\blacksquare, \Box) , (\bullet, \circ) измерялись в магнитных полях B = 1 T [14] (a) и B = 0.86 T [11] (b); область между штрих-пунктирными линиями на рис. 3, a соответствует парамагнитной ромбической фазе PM(B31); χ_{orth}^{-1} , $-\chi_{hex}^{-1}$ — на рис. 3, b соответствуют ромбической (TiNiSi) и гексагональной (Ni₂In) ветвям обратной восприимчивости χ^{-1} ; Θ_{hex} и Θ_{orth} — значения парамагнитных температур Кюри для гексагональной и орторомбической фаз [11].

ной магнитной восприимчивости $(\partial \chi_{\text{orth}}^{-1}/\partial T < 0)$ ниже температуры возникновения орторомбической фазы T_t исключает появление границы лабильности РМ фазы $(\theta_{\text{orth}}^{-1} = 0)$ и возникновение FM порядка путем фазового перехода 2 рода, рис. 3, *а*.

3. Взаимосвязь магнитокалорических и структурных свойств

Вопросы взаимосвязи магнитокалорических свойств и структурных особенностей кристаллической решетки вытекают из одинаковой основы, на которой базируются представления о МКЭ и структурном переходе (СП). Действительно, оба физических явления МКЭ и СП связаны с изменением энтропии системы, вызванным изменением симметрии магнитной и кристаллической подсистем.

Из общих соображений, основываясь лишь на характере сопряжения ферромагнитного порядка с орторомбической симметрией, можно показать в каких случаях величина магнитокалорического эффекта будет усиливаться или ослабляться при совмещении магнитного и структурного переходов.

Изменения объема и параметров магнитного и структурного порядков, сопровождающие магнитоструктурные переходы, должны участвовать в изменении магнитной и кристаллической симметрии системы и напрямую отвечать за изменение магнитоактивной части энтропии. Для понимания роли каждого из явлений, сопровождающих процессы намагничивания исследуемых систем, удобно выделить три вклада в магнитоактивную часть энтропии $S_m(T, P, B)$

$$S_m(T, P, B) = S_y(T, P, B) + S_{\varphi}(T, P, B) + S_{\omega}(T, P, B).$$
(1)

Физика твердого тела, 2018, том 60, вып. 6

Здесь первое слагаемое соответствует энтропии спиновой конфигурации; второе — энтропии структурной конфигурации атомов решетки и третье — энтропии кристаллической решетки как целого. Это слагаемое ответственно за тепловое расширение и соответствует вкладу "статических" фононов. Будем отсчитывать энтропию от наиболее симметричной гексагональной фазы в парамагнитном состоянии $S_0(T, P, B)$. Тогда каждое из слагаемых в (1) можно представить в виде разложения в степенной ряд по параметрам порядка и объемной деформации

1115

$$S_{y}(T, P, B) = S_{0}(T, P, B) - \sum_{n} a_{n} y^{2n}, \quad a_{n} > 0,$$
$$S_{\varphi}(T, P, B) = S_{0}(T, P, B) - \sum_{nm} b_{n} \varphi^{2m},$$
$$S_{\omega}(T, P, B) = S_{\omega=0}(T, P, B) + \frac{\alpha}{n} \omega, \quad \alpha > 0, \ \kappa > 0.$$
(2)

В (2) учтено понижение симметрии системы при возникновении магнитного — y и структурного — φ параметров порядка и, как следствие, понижение энтропии; увеличение относительного объема — ω при положительных коэффициентах объемного расширения α и сжимаемости κ , напротив, увеличивает энтропию.

Изменение энтропии будем рассматривать для случая, когда исходное состояние B = 0, $T > T_C$ соответствует парамагнитной фазе y = 0 и максимальное значение поля $B_0 > B_{k1}$ превышает критическое поле индуцированного перехода РМ–FМ. При этом результаты могут оказаться различными для пниктидов и германидов. Начнем с классического пниктида — арсенида марганца. В MnAs при $T > T_{C2} < T_t = 394$ К исходное РМ состояние соответствует орторомбической

структуре, описываемой конечным значением параметра $\varphi(y = 0, T_1 > T \ge T_{C2})$. В поле с индукцией $B = B_0 > B_{k1}$, превышающей первое критическое значение B_{k1} , происходит индуцированный магнитным полем магнитоструктурный переход PM[orth] \rightarrow FM[hex], который в терминах параметров порядка соответствует переходу PM[$y = 0, \varphi(t > 0)$] \rightarrow FM[$y = y_{\text{FM}}, \varphi(T) = 0$]. Тогда изменение энтропии $\Delta S_m(T, P, \Delta B) = S_m(B = 0)$ $- S_m(B = B_0)$ при нарастании магнитного поля от B = 0до $B = B_0$ определяется выражением

$$\Delta S_m(T, P, \Delta B) = \sum_n a_n y_{\rm FM}^{2n} - \sum_{nm} b_n \varphi(T)^{2m} - \frac{\alpha}{\kappa} \left[\omega_{\rm FM}(y_{\rm FM}) - \omega_{\rm PM}(0, T, \varphi) \right].$$
(3)

Как видно из (3), правая часть является суммой разнознаковых слагаемых. И если вклад от изменения спиновой конфигурации (первое слагаемое) работает на увеличение $\Delta S_m(T, P, \Delta B)$, то магнитоструктурный (второе слагаемое) и магнитострикционный (третье слагаемое) вклады уменьшают значение и, соответственно, величину МКЭ.

Совершенно иная ситуация возникает в германидах, где орторомбическая структура и ферромагнитный порядок взаимообусловлены и поддерживают друг друга, рис. 3. Поэтому для магнитоструктурных переходов PM[hex] \rightarrow FM[orth] понижение структурной ([hex] \rightarrow [orth]) и магнитной (PM \rightarrow FM) симметрий должно приводить к одинаковым знакам для вкладов — $\Delta S_y(T, P, \Delta B)$ и — $\Delta S_{\varphi}(T, P, B)$. В этом случае для $\Delta S_m(T, P, \Delta B)$ получим

$$\Delta S_m(T, P, \Delta B) = \sum_n a_n y_{\rm FM}^{2n} + \left[\sum_{nm} b_n (\varphi(T, y_{\rm FM})^{2m})\right]$$
$$-\frac{\alpha}{\kappa} \left[\omega_{\rm FM}(y_{\rm FM}, T, 0) - \omega_{PM}(0, T, 0)\right]. \tag{4a}$$

Например, для $Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe$ ярко выраженные магнитоструктурные переходы первого рода $PM[hex] \rightarrow FM[orth]$ наблюдаются только под давлением $P \ge 6$ kbar или при атмосферном давлении, но после специальной термообработки. При $P \le 6$ kbar в отожженных сплавах реализуются изоструктурные переходы 1 и 2 родов $PM[orth] \rightarrow FM[orth]$. В этом случае для изоструктурных процессов намагничивания получим

$$\Delta S_m(T, P, \Delta B) = \sum_n a_n y_{\rm FM}^{2n} + \left[\sum_{nm} b_n (\varphi(T, y_{\rm FM})^{2m} - \varphi(T, y = 0)^{2m}) \right] - \frac{\alpha}{\kappa} \left[\omega_{\rm FM}(y_{\rm FM}, T, \varphi) - \omega_{PM}(0, T, \varphi) \right].$$
(4b)

Выражения (3) и (4) отличаются знаками вкладов изменения энтропии структурной конфигурации $\Delta S_{\varphi}(T, P, B)$. Эти результаты, полученные только на основе сведений о симметрии исходного (парамагнитного) и конечного (ферромагнитного) состояний системы, позволяют понять роль различных вкладов в полное изменение магнитоактивной части энтропии системы.

В плане усиления МКЭ в этих материалах имеет смысл проанализировать возможность подавления или стимуляции каким-либо образом влияния магнитоструктурного вклада.

Феноменологическое описание магнитокалорических свойств Mn_{1-t}Ti_tAs и Mn_{1-x}Cr_xNiGe на основе модели взаимодействующих параметров магнитного и структурного порядков

Оценку этих возможностей удобно провести при исследовании температурной зависимости $\Delta S_m(T, P, \Delta B)$ и других магнитокалорических характеристик, рассчитанных в рамках модели взаимодействующих параметров магнитного — у и структурного — φ порядков без учета низкотемпературных антиферромагнитных состояний [10,11]. В этом случае выражение свободной энергии имеет вид

$$G = -a \left[1 + \lambda_0 u_{ll} + \lambda_z u_{zz} - \lambda \varphi^2 - \lambda_1 u_{ll} \varphi^2 - u_{ll} (\lambda_5 \varphi^4 + \Lambda_6 y^2) \right] y^2 TS(y) - M_0 y H + \left[\frac{1}{2} u_{ll}^2 k_0 + \frac{1}{2} k_z u_{zz}^2 + \frac{1}{2} k_{0z} u_{zz} u_{ll} + \frac{1}{2} k_1 (u_{xx} - u_{yy})^2 + P u_{ll} - T(v_0 u_{ll} + v_z u_{zz}) \right] + \left[\frac{1}{2} A (T - T_t') \varphi^2 + \frac{1}{4} B \varphi^2 + \frac{1}{6} C \varphi^6 \right] + \varphi^2 \left[(\Lambda_0 + \lambda_5 \varphi^2) u_{ll} + \Lambda_z u_{zz} + L_1 (u_{xx} - u_{yy}) \right], \quad (5)$$

где $S(y) = Nk[s_{3/2}(0) - s_{3/2}(y)] \equiv Nk[\ln(2s+1) - s_{3/2}(y)]$ — энтропия спиновой конфигурации для s = 3/2; $y = M/M_0$; $a = 0.9Nk_BT_0$; N — число магнитоактивных ионов на единицу объема; k_B — постоянная Больцмана; M_0 , H — намагниченность насыщения и внешнее магнитное поле; первая скобка в (5) включает инварианты обменного, магнитоупругого и магнитоструктурного взаимодействия; во второй скобке размещены инвариантные комбинации, описывающие упругую энергию, энергию давления — P и решеточную энтропию для гексагональной решетки; третья и четвертая скобки описывают структурного порядка $\varphi = (u_1 - u_2 + u_3 - u_4)/4a_{hex}\sqrt{3}$ с упругими деформациями — $u_{ik}(u_{ll} = \omega)$; T_0, T_t' — температуры спонтанных магнитного и структурного



Рис. 4. Полевые и температурные зависимости магнитных, магнитокалорических и структурных характеристик в MnAs. Символы — эксперимент [15]: сплошные и штрих-пунктирные линии — равновесные и неравновесные состояния в магнитоструктурной теории; штриховые линии соответствуют изоструктурной теории: *a*) стрелки вверх(вниз) определяют величины критических полей $B_{k1}(B_{k2})$ скачкообразного возникновения (исчезновения) гексагонального состояния $B8_1$; *b*) кривые слева направо соответствуют возрастанию поля 1.5 T - 5.0 T - 7.0 T - 8.5 T - 10 T; стрелки вверх (вниз) определяют температуры $T_1(T_2)$ возникновения(исчезновения) гексагонального состояния $B8_1$; температуры смещения $T_t(B)$ парамагнитного структурного перехода PM(hex,NiAs)-PM(orth,MnP) обозначены вертикальными линиями.

переходов при отсутствии всех вышеуказанных взаимодействий. Слагаемое $\Lambda_1(u_{xx} - u_{yy})\varphi^2/2$ в (5), описывающее взаимодействие между структурным параметром порядка и орторомбическими искажениями $(u_{xx} - u_{yy})$ гексагональной решетки как целого, ответственно за нарушение соотношения $c_{\text{orth}} - b_{\text{orth}}\sqrt{3} = 0$ при возникновении смещений атомов марганца u_1, u_2, u_3, u_4 из положений равновесия в гексагональной структуре [11].

Значение S = 3/2 выбиралось исходя из среднего эффективного значения магнитного момента сплава Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe — $\mu = (\mu_{\rm PM} + \mu_{\rm PM})/2 \approx 3.38 \,\mu_B$. Здесь значение $\mu_{\rm FM} \approx M_0 A/5585 = 2.66 \mu_B$ определялось по намагниченности насыщения $M_0 = 80 \,{\rm emu}/g$ и молекулярному весу A = 185.91 формульной единицы; значение $\mu_{\rm PM} = \sqrt{3K_{\rm B}A0.01/(N_{\rm A}\mu_B^2 \,{\rm tg}\,\alpha)} = 2.11 \mu_B$ определялось из измерений тангенса угла наклона (tg α) обратной магнитной восприимчивости (рис. 3, b) ($N_{\rm a}$ — число Авогадро).

Уравнения состояния $\partial G/\partial u_{ll} = 0$, $\partial G/\partial (u_{xx} - u_{yy}) = 0$, $\partial G/\partial (u_{zz} = 0, \partial G/\partial \varphi = 0, \partial G/\partial y = 0$ позволяют рассчитать различные типы зависимостей равновесных величин u_{ll} , u_{zz} , $u_{zz} - u_{yy}$, φ , y и, из сравнения с экспериментальными данными, оценить знаки и величины большинства коэффициентов λ , $\Lambda_i \nu_0$, ν_1 . В качестве примера на рис. 4,5 приведен ряд характерных экспериментальных и теоретических зависимостей, позволяющих провести адекватную оценку пригодности теории для качественного описания исследуемых магнитных и магнитокалорических явлений. Анализ графиков показывает, что в рамках изоструктурной модели (штриховые линии и $\varphi(T) \equiv 0$ на рис. 4) невозможно описание всех особенностей индуцированных полем переходов в MnAs. Напротив, при использовании модели, учитывающей возможность изменения симметрии решетки, удается адекватно интерпретировать эти особенности. Например, становится понятным, что скачкообразные переходы первого рода при $T \le 344$ K, $B \approx 8 \, \text{T}$, предшествующие возникновению ферромагнитной фазы при B = 14 T, соответствуют парамагнитным переходам первого рода PM(orth)-PM(hex) цепочке переходов PM(orth)-PM(hex)-FM(hex). в В рамках магнитоструктурной модели (сплошные и штрих-пунктирные линии) эта цепочка сопоставляется последовательности переходов первого и второго рода $PM(\phi \neq 0) - PM(\phi = 0) - FM(\phi = 0)$. Штрихпунктирные линии соответствуют метастабильным состояниям. В изоструктурной модели скачкообразные



Рис. 5. Изменение температурных зависимостей магнитных и структурных характеристик образца $Mn_{0.89}Cr_{0.11}$ NiGe при воздействии гидростатического давления. Символы — эксперимент ($B_0 = 1$ T) [16]; сплошные и штрих-пунктирные линии — равновесные и неравновесные состояния (теория, $B_0 = 0$). *P*, kbar: P = 0 (*a*); P = 4 (*b*); P = 11 (*c*); вертикальные стрелки вверх (вниз) при нагревании (охлаждении) определяют: температуры возникновения (исчезновения) состояний PM(hex) (*a*1, *b*1, *c*1) и температуры возникновения (исчезновения) состояний FM(orth) на остальных рисунках.

переходы первого рода при $T \ge 344 \,\mathrm{K}$ не могут быть описаны в принципе (рис. 4, а). При описании температурных зависимостей M(t), $\phi(T)$, S(T) проявляются как обнаруженные ранее экспериментально, так и не известные особенности MnAs. К известным можно отнести возрастание — уменьшение намагниченности в области температуры T_t парамагнитного структурного перехода PM(hex,NiAs)-PM(orth,MnP), по которым фиксируется смещение этой температуры по полю, рис. 4, b1. К неизвестным результатам можно отнести обрезание зависимостей S(T) линиями $S_B - S_B$. На рис. 4, b2 показаны лини
и $S_{1.5} {-} S_{1.5}$ и $S_{8.5} {-} S_{8.5}$ для $B = 1.5\,{\rm T}$ и для $B = 8.5 \, \text{T}$. Эти линии соответствуют структурному вкладу $-1/2A\varphi(T)^2$ в формуле (5). Возникновение этого обрезания описывает механизм уменьшения $\Delta S_m(T, P, \Delta B)$, выведенный в (3) из общих соображений.

Для германидов, $Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe$ рис. 5, модель позволила:

— предсказать скачкообразное поведение парамагнитной восприимчивости в области PM структурного перехода первого рода $hex(Ni_2In)$ —orth(TiNiSi), рис. 5, *a*3; — объяснить изменение процесса магнитного упорядочения от изоструктурного перехода второго рода PM(orth, TiNiSi)—FM(orth, TiNiSi) (рис. 5, *a*) к магнитоструктурному переходу первого рода PM(hex,Ni_2In)— FM(orth, TiNiSi) (рис. 5, *c*) при возрастании давления до 11 kbar;

 обосновать изменение типа магнитного фазового перехода при промежуточных величинах давления P = 4 kbar от магнитоструктурного фазового перехода $PM(hex, Ni_2In) \rightarrow FM(orth, TiNiSi)$ при понижении температуры к изоструктурному фазовому переходу FM(orth, TiNiSi) $\rightarrow PM(orth, TiNiSi)$ при последующем повышении температуры (рис. 5, *b*2, *b*3) и получить удовлетворительное согласие между экспериментальной и теоретической P-T диаграммами, рис. 2, *c*.

Эти примеры показывают адекватность описания особенностей магнитных свойств в исследуемых системах, а потому можно с доверием отнестись к результатам теоретических вычислений для магнитокалорических характеристик. На рис. 6 приведены рассчитанные в рамках модели изобарические температурные зависимости этих величин для MnAs

$$\Delta S_m(T, P, \Delta B), \quad \Delta Q(T, P, \Delta B) = T \Delta S_m(T),$$

$$\Delta T(T, P, \Delta B) = \Delta S_m(T, P \Delta B) / (C_{P,B}/T);$$

$$\Delta S_m = S_m(T, P, B = 0) - S_m(T, P, B = B_0).$$

Здесь полная магнитная составляющая энтропии системы определяется как $S_m \equiv -\partial G/\partial T$, что дает

$$S_m(T) \equiv Nk \ln(2S+1) - S_y(y) - \frac{1}{2}A\varphi(T)^2 + (\nu_0 u_{ll} + \nu_z u_{zz}).$$
(6)

Тут значения параметров порядка и деформаций соответствуют равновесным для заданных температуры, давления и индукции.



Рис. 6. Влияние структурного перехода на магнитокалорические характеристики в MnAs. **•**, \Box — расчетные зависимости при нагревании, охлаждении в теории взаимодействующих параметров магнитного и структурного порядка при P = 0; **•**, \triangle — тоже при P = -2.8 kbar; когда $\varphi(T) = 0$; штриховые линии соответствуют изоструктурной теории при P = 0, когда $\varphi(T) \equiv 0$.

При атмосферном давлении, когда структурный вклад в MnAs является магнитоактивным и процессы намагничивания (размагничивания) сопровождаются магнитоструктурными переходами $PM[orth] \leftrightarrow FM[hex]$, теоретические зависимости $S_m(T)$ приведены на рис. 6 для двух случаев. Сплошные линии с символами . соответствуют учету магнитоструктурного вклада в ΔS_m и близки к экспериментальным [15]; штриховые линии без символов соответствуют изоструктурной теории, в которой $\varphi(T) \equiv 0$. При гидростатическом расширении (\blacktriangle , \bigtriangleup) до давлений P = -2.8 kbar орторомбическая структура становится неустойчивой во всем диапазоне температур ($\phi(T) = 0$). В этом случае процессы намагничивания (размагничивания) сопровождаются изоструктурными фазовыми переходами 1-го рода $\mathrm{PM}[y=0, \varphi(T)\equiv 0] \leftrightarrow \mathrm{FM}[y_{\mathrm{FM}}, \varphi(T)\equiv 0].$ Магнитокалорические характеристики в этом случае существенно увеличиваются, а сами зависимости смещаются в область более высоких температур. На практике подобная ситуация может быть достигнута в системе $Mn_{1-t}Ti_tAs$ (рис. 2). Как видно из рисунка, при t = 0.06 магнитное упорядочение еще реализуется как переход первого рода PM[hex]-FM[hex], но целиком в пределах гексагональной симметрии.

Для германидов, как уже отмечалось ранее, ситуация с МКЭ должна быть иной. Так, при атмосферном давлении для отожженного образца Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe магнитное разупорядочение реализуется как изоструктурный переход второго рода PM[orth]-FM[orth]. Изменение (\circ) энтропии $\Delta S_m(T, P = 0, \Delta B_0 = 9T)$, pacсчитанное по соотношению Максвелла для изоструктурного намагничивания, представлено на рис. 7, а. Здесь же (\blacksquare , \Box) приведена зависимость $\Delta S_m((T, P = 0,$ $\Delta B_0 = 9 \mathrm{T}$)) для закаленного образца, в котором МКЭ сопровождает магнитоструктурный переход первого рода PM(hex)-FM(orth). Как видно из графиков, изменение $\Delta S_m(T, P, \Delta B)$ в случае магнитоструктурного намагничивания (размагничивания) значительно превышает аналогичную величину для случая изоструктурного намагничивания. При теоретическом описании эти два варианта реализуются для двух значений давления: (o) — P = 0 и (\blacksquare , \Box) — P = 9 kbar, рис. 7, b.

При промежуточном давлении ($P = 7 \, \text{кбар}$) теория предсказывает еще более нетривиальное поведение зависимости $\Delta S_m(T, P, \Delta B_0)$. На рис. 8, *а* для зависимости $\Delta S_m(T, P = 7 \, \text{kbar}, \Delta B_0 = 9 \, \text{T})$ при нагрева-



Рис. 7. Возрастание ΔS_m при барическом стимулировании магнитоструктурного переходов PM(hex)–FM(orth) в Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe. (*a*) — экспериментальные зависимости $\Delta S_m(T)$ в быстрозакаленном Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe. Быстрая закалка образца выполняет роль давления. (*b*) — \circ (**•**, \Box) — расчетные зависимости $\Delta S_m(T)$ при P = 0 (P = 9 kbar).



Рис. 8. Разделение изоструктурного и магнитоструктурного вкладов на температурной зависимости $\Delta S_m(T)$ в системе $Mn_{1-x}Ni_xNiGe$. (*a*) — (**n**) — разделение изоструктурного и магнитоструктурного вкладов ΔS_m при нагревании в $Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe$ под давлением P = 7 кбар (теория); (*b*) — (**n**) — разделение изоструктурного и магнитоструктурного вкладов ΔS_m при нагревании в $Mn_{0.82}Cr_{0.18}NiGe$ при атмосферном давлении (эксперимент) [13].

нии можно четко выделить две составляющих. Плоская площадка в пределах температурного диапазона: 375 К-383 К соответствует, согласно теоретической P-T диаграмме на рис. 2, *c* для $B_0 = 0$, ромбической симметрии. Поэтому здесь возможно только изоструктурное перемагничивание, которое сопровождается изоструктурным переходом первого рода PM($\varphi_{PM} \neq 0$, orth)-FM($\varphi_{FM} \neq 0$, orth). За пределами этого диапазона температур спонтанное существование орторомбического состояния невозможно, поэтому размагничивание при изменении поля $\Delta B_0 = 9 \,\mathrm{T}$ сопровождается магнитоструктурным переходом первого рода $FM(\varphi_{FM} \neq 0, orth) - PM(\varphi_{PM} = 0, hex)$. Отчетливо видно, что магнитоструктурная составляющая приводит к увеличению $\Delta S_m(T, P, \Delta B_0)$ почти на 10 J/K·kg. Здесь, в отличие от первого случая (рис. 7, a), сравнение изоструктурного и магнитоструктурного вкладов является более адекватным, поскольку оба процесса перемагничивания сопровождаются переходом одного рода первого. Эти результаты качественно подтверждаются исследованиями магнитокалорических свойств сплава $Mn_{0.82}Cr_{0.18}NiGe$, проведенными при атмосферном давлении в [13], рис. 8, *b*. Можно предположить, что свойства этого сплава при атмосферном давлении в какойто степени дублируют свойства сплава $Mn_{0.89}Cr_{0.11}NiGe$ под давлением (рис. 8, *a*), поскольку увеличение содержания хрома приводит к сжатию решетки. Легко видеть, что для обоих случаев (рис. 6, рис. 8) наблюдается прежде всего качественное согласие между структурными особенностями зависимостей $\Delta S_m(T, P, \Delta B)$. При этом различия в величинах температурного гистерезиса ($\Delta T_{theor} > \Delta T_{exp}$) между экспериментальными и теоретическими зависимостыю модельных и "размытостью" экспериментальных кривых.

5. Выводы

На основе теоретического анализа магнитных и магнитокалорических свойств систем $Mn_{1-t}Ti_tAs$ и $Mn_{1-x}Cr_xNiGe$ можно сделать следующие выводы.

1. Основные особенности магнитных и магнитокалорических свойств систем $Mn_{1-t}Ti_tAs$ и $Mn_{1-x}Cr_xNiGe$ обусловлены взаимодействием параметров магнитного и структурного порядков.

2. Для усиления магнитокалорических свойств пниктидов на основе MnAs целесообразно ослабить влияние структурной составляющей в процессах перемагничивания этих материалов. Этому может способствовать легирование Тi, которое моделирует воздействие отрицательного давления на образец и подавляет орторомбическую фазу во всем диапазоне температур.

3. Усиление магнитокалорических свойств германидов системы $Mn_{1-x}Cr_xNiGe$, напротив, связано с совмещением структурно-симметрийного и магнитного переходов. В этом случае сжатие образца путем легирования, закалки или прямого воздействия гидростатического давления приводит к вовлечению гексагональной и ортогональной фаз в формирование максимальной величины магнитоактивной составляющей энтропийного вклада.

4. Размытость фазовых переходов существенно снижает полезные для практики характеристики магнитных и магнитокалорических зависимостей.

6. Заключение

Проведенный на основе модели взаимодействующих параметров магнитного и структурного порядка анализ магнитных и магнитокалорических свойств систем $Mn_{1-t}Ti_tAs$ и $Mn_{1-x}Cr_xNiGe$ позволяет объяснить ослабление магнитокалорического эффекта в пниктидах и его увеличение в германидах влиянием структурной части энтропии. В рамках модели дано качественное объяснение ряду особенностей, магнитных свойств, впервые обнаруженных в настоящей работе при воздействии на образцы исследуемых систем сильного магнитного поля и гидростатического давления.

Список литературы

- [1] С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1971). 1032 с.
- [2] А.С. Андреенко, К.П. Белов, С.А. Никитин, А.М. Тишин. УФН **158**, 553 (1989).
- [3] В.И. Митюк, Н.Ю. Панкратов, Г.А. Говор, С.А. Никитин, А.И. Смаржевская. ФТТ 54, 1865 (2012).
- [4] А.П. Сиваченко, В.И. Митюк, В.И. Каменев, А.В. Головчан, В.И. Вальков, И.Ф. Грибанов. ФНТ 39, 1350 (2013).
- [5] И.Ф. Грибанов, А.П. Сиваченко, В.И. Каменев, В.И. Митюк, Л.И. Медведева, Е.А. Дворников, Т.С. Сиваченко. ФТВД 23, 3, 15 (2013).
- [6] А.В. Головчан, И.Ф. Грибанов. ФТВД **23**, *3*, 23 (2013).
- [7] J.S. Niziol, A. Zieba, R. Zach, M. Baj, L. Dmowski. JMMM 38, 205 (1983).
- [8] Н.В. Мушников. УФН 182, 450 (2012).
- [9] N. Menyuk, J.A. Kafalas, K. Dwight, J.B. Goodenough. Phys. Rev. 177, 942 (1969).
- [10] В.И. Вальков, Э.А. Завадский, Б.М. Тодрис, С.К. Асадов. ФТТ 24, 153 (1982).
- [11] В.И. Вальков, В.И. Каменев, В.И. Митюк, И.Ф. Грибанов, А.В. Головчан, Т.Ю. Деликатная. ФТТ 59, 26 (2017).
- [12] А.А. Галкин Э.А. Завадский, В.И. Вальков, И.Ф. Грибанов, Б.М. Тодрис. ДАН СССР 246, 862 (1979).
- [13] A. Szytuła, S. Baran, T. Jaworska-Gołąb, M. Marzec, A. Deptuch, Yu. Tyvanchuk, B. Penc, A. Hoser, A.P. Sivachenko, V.I. Val'kov, V.P. Dyakonov, H. Szymczak. J. Alloys Comp. 726 978 (2017).
- [14] И.Ф. Грибанов, В.И. Вальков, В.Д. Запорожец, В.И. Каменев, В.И. Митюк, А.П. Сиваченко, В.В. Бурховецкий. Сб. трудов Междунар. конф. "Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в конденсированных средах". Махачкала, 6–9 сентября 2017 г. С. 73–76.
- [15] Б.М. Тодрис. Изменение типа магнитного превращения в сплавах MnAs–MnSb, MnAs–NiAs. Канд. дисс. Донецк (1978). 23 с.
- [16] Ю.С. Кошкидько, Э.Т. Дильмиева, Я. Цвик, К. Рогатский, А.П. Каманцев, В.В. Коледов, В.И. Вальков, А.П. Сиваченко. Частное сообщение.